

Optocoupler

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

VISHAY Semiconductor GmbH Theresienstraße 2 74072 Heilbronn

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

> Optokoppler Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN EN 60747-5-5 (0884-5):2015-11; EN 60747-5-5:2011; A1:2015

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungstelle (Certification

G. Heine VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: VDE certificates are valid only when published on:



Aktenzeichen: 422610-4880-0056 / 242629 File ref.: Ausweis-Nr. 112774 Blatt 1 Certificate No. Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / ruhter conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1999-05-31 (letzte Änderung / updated 2017-09-29)

http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate



Revision: 22-Nov-17

1 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> Document Number: 83580



Blatt /

Page

2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-0056 / 242629 / EC22 / SCT letzte Änderung / updated 2017-09-29

Datum / Date 1999-05-31

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

112774

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112774. *This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112774.*

Optokoppler Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

1]	LH1262
2]	LH1262EB
3]	LH1521
4]	LH1523
5]	LH1502
6]	LH1512
7]	LH1503
8]	LH1513
9]	LH1514
10]	LH1505
11]	LH1520
12]	LH1522
13]	LH1526
14]	LH1531
15]	LH1532
16]	LH1533
17]	LH1544
18]	LH1527
19]	LH1537
20]	VO1263
21]	LH1529
22]	LH1556
23]	VO15665P8
24]	VO15665P5
25]	P-3072A
26]	P-3085A
27]	LH1503A
28]	LH1505A
29]	LH1513A
30]	LH1520A
Fortse	tzung siehe Blatt
contin	ued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

3/

Telefon +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555

2

Document Number: 83580



VD Zei	E Prüf- und Zert chengenehmigu	tifizierungsinstitut Ing	Auswei Certific 11277	ate No. Page
		/ Name and registered seat of the Certificate hold presignstraße 2, 74072 Heilbronn	er	
	eichen / <i>File ref.</i> 0-4880-0056 / 242629 / EC22		zte Änderung / <i>updated</i>)17-09-29	Datum / <i>Date</i> 1999-05-31
Dieses This su	Blatt gilt nur in Verbindung mit B Upplement is only valid in conjunc	latt 1 des Zeichengenehmigungsausweises tion with page 1 of the Certificate No. 11277	Nr. 112774. 4.	
	okoppler ocoupler			
Typ(er) / Type(s)			
31] 32] 33]	LH1522A LH1532A LH1533A			
34] 35] 36] 37]	LH1529A LH1529B LH1556A VO15665			
Weiter	re Angaben siehe Anlagen er information see appendix	200K1, 200K2, 300M1 und 500Z1 vom 200K1, 200K2, 300M1 and 500Z1 dated		
VDE Fachg	Prüf- und Zertifizierungsinstitu Testing and Certification Instit gebiet EC22 on EC22			
				∩V⊧
	VDE F	rüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certificati	on Institute	<u></u>

3

0-

For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT <u>www.vishay.com/doc?91000</u>



VDE Prüf- und Zeichengeneh	Zertifizierungsinstitut migung		Ausweis-Nr Certificate N 112774		Beiblatt / Supplement	
Name und Sitz des Genehmigung VISHAY Semiconductor Gr	s-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate h nbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn	older				
Aktenzeichen / <i>File ref.</i> 422610-4880-0056 / 24262	9 / EC22 / SCT	letzte Änderung / 2017-09-29		Datum / 1999-(
Dieses Beiblatt ist Bestandteil This supplement is part of the	des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112774. Certificate No. 112774.					
Optokoppler <i>Optocoupler</i> Fertigungsstätte(n)						
Place(s) of manufacture						
Referenz/ <i>Reference</i> 30009952	Vishay Semiconductor Malaysia Sdn. Bhd. 1710-1 Krubong Ind. Park Mukim Krubong 75250 MELAKA Melaka MALAYSIA					
VDE Prüf- und Zertifizierur VDE Testing and Certificat Fachgebiet EC22 Section EC22						

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach



4

Document Number: 83580

For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT <u>www.vishay.com/doc?91000</u>

Vishay Semiconductors



Aktenzeichen: File reference:	en: 422610-4880-0056/242629 hce:	Au Ce	Ausweis-Nr.: Certificate No.:	112774		Anlage Nr.: Appendix No.:		200K1	Seite: Page:	1/6	Datum: Date:		2017-09-29
iese Anlage i	Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.	. This appendix is p	art of the certificat	ő									
Optokoppler Optocoupler	ler ler												
Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Cerlificate Type(s)		juduj 6ue6uj3	ຍາຣຣະນ4 ງາດງາບ	Lay-Out Footprint – Iningtoo Tay-Val	Lay-Out Foothme - inhotood الmm. [mm]	βuβare Kriechserke Eingang - βuster External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max, periodische Spitzenisolationsspg. Max, repetitive peak isolation voltage U _{IORM} [V peak]	punnaqasnoitslosi anaisel minixeM Maximum transient isolation voltage الماسينية مارامين [V peak]	Pollution degree	Klimatic category Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	L _{sig} [°C] Storage temperature range Lagertemperature
-	62	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62		≥ 7,0 ≥ 8.0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
2 LH126	LH1262EB	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,6			≥ 7,0 ≥ 8.0	890 1130	8000	2	40/100/21 -	-40 +100	-40 +150
3 LH1521	21	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62		≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	5	40/100/21	-40 +100	-40 +150
4 LH1523	23	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,6		≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	5	40/100/21	-40 +100	-40 +150
5 LH1502	02	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,6		≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
6 LH1512	12	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,6		≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	5	40/100/21	-40 +100	-40 +150
7 LH1503	03	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62		≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
VDE			VDE Prüf- un VDE Testu	VDE Prüf- und Zertifitzierungsinstitut GmbH – TL73 VDE Testing and Certification Institute – TL73	gsinstitu	tt GmbH – stitute – T	. TL73 L73						E

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Revision: 22-Nov-17

5 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u>

Vishay Semiconductors



	Certificate No.: s part of the certificate. Ausgang MoS-IC MOS-IC	41 muminim – Inhqtoor Tuo-yeu muminim – Inhqtoor Tuo-yeu [mm]	Appendix N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	[uw]	2 2 3 3 Max, repetitive peak isolation voltage U _{lotin} [V peak]	P D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	 Verschmulzungsgrad Verschmulzungsgrad 	Pate Date Climatic category Climatic category Date Climatic category Climatic category	4 Betriebstemperature range 5 5 5 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6 9 7 10 7 11 10 12 10 13 10 14 10 15	4 b Lagertemperature range 1 1 Taig [°C]
GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000		1.2/001/0	-40 14100	-+10
GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2 4	40/100/21	-40 +100	-40 +150
GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2 4	40/100/21	-40 +100	-40 +150
GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62 10.16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2 4	40/100/21	-40 +100	-40 +150
GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2 4	40/100/21	-40 +100	-40 +150
GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2 4	40/100/21	-40 +100	-40 +150

Revision: 22-Nov-17

6 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u>

Vishay Semiconductors



Anlage ist Bestar	422610-4880-0056/242629	Aus Cer	Ausweis-Nr.: 11: Certificate No.: 11:	112774	44	Anlage Nr.: Appendix No.:		200K1	Seite: Page:	3/6	Date:		2017-09-29
	Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.	his appendix is pa	t of the certificate.										
Optokoppler Optocoupler													
⊃osition in VDE-Certificate [γp(en) [γpe(s)	6ue6u;3	jnduj	ງກdງກO	Lay-Out Footprint – Iningtoo I JuO-yeJ muminim – Iningtoo I JuO-yeJ muminim – Iningtoo I JuO-yeJ	Žu) Řußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang	tuqiuO - 1uqnl əoratsib əpsqəənə lsmətz [mm] prasevA - prasmatika - brasing	External clearance input - Output External clearance input - Output	Max, periodische Spitzenisolation voltage Uesa, repetitive peak isolation voltage U _{losм} [V peak]	gnunneqzentisolational elemixeM Mamizel munixeM Unnı [V реак]	Pollution degree	Klimakiasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage femperature range T _{sig} [°C]
. =	0		MOS-IC	7,62		≥ 7,0 ≥	≥ 7,0	890	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
				10,16	1	1	α'N	0011				007. 07	1011101
LH1533	0	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16		≥ 7,0 ≥ ≥ 8,0 ≥	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	~	40/100/21	-40 +100	-40 +150
LH1544	0	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16		≥ 7,0 ≥ ≥ 8,0 ≥	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
LH1527	G	GaAlAs Diode	MOS-IC	7,62		> 7,0	≥ 7,0 > 8.0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
1 114597		Gadlde Dinde	MOS-IC	7.62	1	1	7,0	890	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
)			10,16			≥ 8,0	1130					
V01263	0	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62		≥ 7,0 ≥	≥ 7,0 > 0,0	890	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
				10,1	1	1	0,0	0011		T		007.07	-
LH1529	0	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16		≥ 7,0 ≥ ≥ 8,0 ≥	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 15U

Revision: 22-Nov-17

7 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> Document Number: 83580

Vishay Semiconductors



Aktenze	Aktenzeichen: File reference:	422610-4880-0056/242629	Ausv Certi	Ausweis-Nr.: Certificate No.:	112774		Anlage Nr.: Appendix No.:		200K1	Seite: Page:	4/6	Datum: Date:	<u></u>	2017-09-29
Diese Anla	lage ist Best	Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate	appendix is part	of the certificate										
Optokoppler Optocoupler	oppler oupler													
Position im VDE-Certificate Position in VDE-Certificate Typ(en)	(s)ədλ <u>ι</u> (uə)dλ	enegni ³	ןחלען	gnsgeuA JuqluO	auminim – trintor3 tuOve l	Lay-Out Footprint – mininim ل.ay-Out Footprint – Lay-Out Footprint [mm]	Řußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Åußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max, periodische Spitzenisolationsspg. Max, repetitive peak isolation voltage Urom [V реаk]	gunneqesnoitslositional mainiseM Maximum transient isolation voltage UlonM [V peak]	Pollution degree Pollution degree	Kilmakiasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	L ^{aie} [°C] Storage temperaturbereich T _{aie} [°C]
22 LF	LH1556	GaAIAs	IAs Diode	MOS-IC	2	7,62	≥ 7,0 > 8.0	≥ 7,0 > 8.0	890 1130	8000	5	40/100/21	-40 +100	-40 +150
23 VG	VO15665P8	GaAlAs	IAs Diode	MOS-IC	2	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	068	8000	2	40/105/21	-40 +105	-40 +150
-	NOTECEDE	Gables	Ide Diode	MOS-IC	1	0,16	≥ 8,0 ≥ 7,0	≥ 8,0 ≥ 7.0	890	8000	2	40/105/21	-40 +105	-40 +150
47 A	C LCOOCI O					10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	1130					
25 P.	P-3072A	GaAlAs	IAs Diode	MOS-IC	1	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/105/21	-40 +105	-40 +150
26 P.	P-3085A	GaAlAs	IAs Diode	MOS-IC	2 1	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/105/21	-40 +105	-40 +150
27 LI	LH1503A	GaAIAs	IAs Diode	MOS-IC	1	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	7	40/100/21	-40 +100	-40 +150
28 LI	LH1505A	GaAlAs	IAs Diode	MOS-IC	21	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	2	40/100/21	-40 +100	-40 +150
				VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH – TL73	d Zertifizieru	Ingsinstitu	ut GmbH -	- TL73						

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Revision: 22-Nov-17

8 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u>

Vishay Semiconductors



VISHAY

	File relevance: Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.	422610-4880-0056/242629 Aus Cer dteil des Genehmigungsausweises. <i>This appendix is pa</i>	Ausweis-Nr.:: 112774 Certificate No.: s part of the certificate.		Appendix No.:	ix No.:		200K1	200K1	Page:		zuoni Page: 310
Optokoppler Optocoupler	opler upler											
Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate Type(s) 7'vpe(s)	(s)əd/ <u>1</u>	ງກduj ອົນອອີນເອັ	ຍດອອນA ອາດຊານO	Lay-Out Footprint – Iningtoo TyoO-VaJ Lay-Out Footprint – Iningtoo TyoO-YBJ [mm]	Åulsere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	ğınışere Luftstecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. repetitive peak isolation voltage	U _{IORM} [V peak]		U _{וסואא} [V реак] Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage Maximum transient isolation voltage Molunion deagred Pollution degree	U _{IORM} [V реак] Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage Pollution degree Climatic category	U _{юкм} [V реак] Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage Verschmutzungsgrad Pollution degree Kilmaklasse
29 LH15	LH1513A	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62	≥ 7,0 > e 0	≥ 7,0 > o 0	890		8000	2	2 40/100/21	2
30 LH1	LH1520A	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890		8000	2	2 40/100/21	2
31 LH15	LH1522A	GaAIAs Diode	MOS-IC	10,16 7.62	≥ 8,0 ≥ 7.0	≥ 8,0 ≥ 7.0	1130 890		8000	2	2 40/100/21	2
				10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	1130					
32 LH1	LH1532A	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130		8000	N	2 40/100/21	N
33 LH15	LH1533A	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130		8000	7	2 40/100/21	7
34 LH15	LH1529A	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130		8000	2	2 40/100/21	2
35 LH1	LH1529B	GaAIAs Diode	MOS-IC	7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130		8000	7	2 40/100/21	7

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Revision: 22-Nov-17

9 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> Document Number: 83580

Vishay Semiconductors



Aktenzeichen: File reference:	422610-4880-0056/242629	Ausweis-Nr.: Certificate No.:	112774	Anlage Nr.: Appendix No.:		200K1	Seite: Page:	9/9	Datu Date	Datum: 20 Date: 20	2017-09-29	29
Diese Anlage ist Best	Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.	ppendix is part of the certif	īcate.									
Optokoppler Optocoupler												
Position im VDE-Certificate Position in VDE-Certificate Type(s) Type(s)	juduj	bue6sn∀	لay-Out Footprint – hindtood tuO-ye لay-Out Footprint – hindtood tuO-ye muminim – hindtood tuO-yea	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	ğulsere Luftstrecke Eingang - βusgang External clearance Input - Output [mm]	.xeM Max. repetitive peak isolation voltage Max. repetitive peak isolation voltage V _{looM} [V peak]	gnunnsqsanoitsloaisludmi əlsmixsM əganov noitslaar isolation voltage U _{non} I (Vəqa'l	Pollution degree Pollution degree	Klimatic category Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich	L ^{aið} [°C] Storage temperature range
36 LH1556A	GaAlA	GaAlAs Diode MOS-IC	C 7,62 10,16	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1130	8000	0	40/100/21	-40 +100		-40 +150
37 VO15665	GaAlA	GaAlAs Diode MOS-IC		≥ 7,0 > 0.0	≥ 7,0 > ¤ 0	890	8000	2	40/105/21	-40 +105		-40 +150



VDE

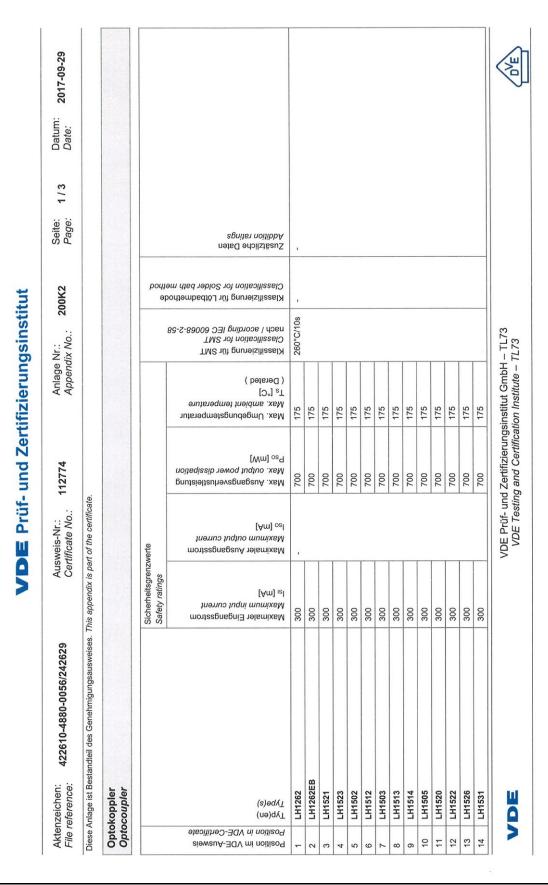
Revision: 22-Nov-17

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

10 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> Document Number: 83580

VDE Certificate 112774





Revision: 22-Nov-17

Document Number: 83580

VDE Certificate 112774



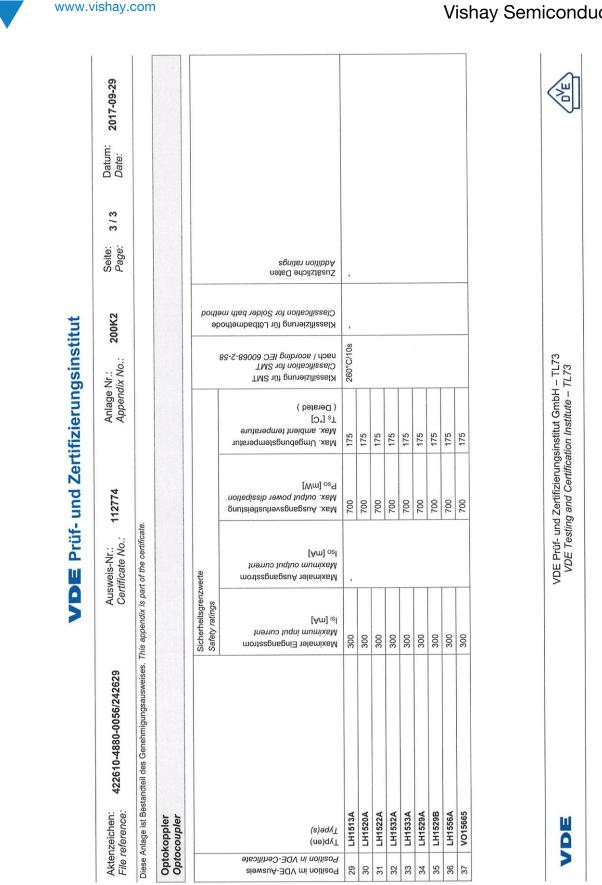
Vkten: File re	Aktenzeichen: 422610-4880-0056/242629 File reference: 422610-4880-0056/242629 Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. <i>This app</i>	422610-4880-0056/242629 dteil des Genehmigungsausweises. <i>This</i>	Aus Cer appendix is pai	Ausweis-Nr.: Certificate No.: endix is part of the certificate.	112774 e.	Anlage Appen	Anlage Nr.: Appendix No.:	200K2	Seite: Page:	2/3 Datum Date:	 2017-09-29
Optok	Optokoppler Optocoupler										
			Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings	verte							
Position in VDE-Certificate	(s)əd <i>\</i> T (n9)qY	mottssgngstrom	Maximular input current [Am] _{Isl}	mortsegnsgeuA ralismixsM tnervus tuqtuo mumixsM [Am] _{os} l	gnutaielisuhayangsverlustleistung Max, output power dissipation P _{so} [Wm]	(Derated) Max, umbient temperature Max, ambient temperature T_s [PC]	Klassifitsierung für SMT Classifitetion for SMT nach / acording IEC 60068-2-58	Alassifiserung für Lötbadmorok Massification for Solder bath me	nətsƏ ərbitstêsuZ spriter retings		
15	LH1532	ē	300		700	175	260°C/10s	-	3		
16	LH1533	e	300		700	175					
17	LH1544	e	300		700	175					
18	LH1527	e	300		700	175					
19	LH1537	e	300		700	175					
20	V01263	3	300		700	175					
21	LH1529	3	300		700	175					
22	LH1556	3	300		700	175					
23	VO15665P8	3	300		700	175					
24	V015665P5	3	300		700	175					
25	P-3072A	e	300		700	175					
-	P-3085A	e	300		700	175					
27	LH1503A	3	300		700	175					
28	LH1505A	3	300		700	175					
>	VDE			VDE Prüf- un VDE Test	nd Zertifizierung	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH – TL73 VDE Testing and Certification Institute – TL73	1– TL73				OVE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Revision: 22-Nov-17

For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u>

Document Number: 83580



Revision: 22-Nov-17

SHAY

13 For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com Document Number: 83580

VDE Certificate 112774

Vishay Semiconductors